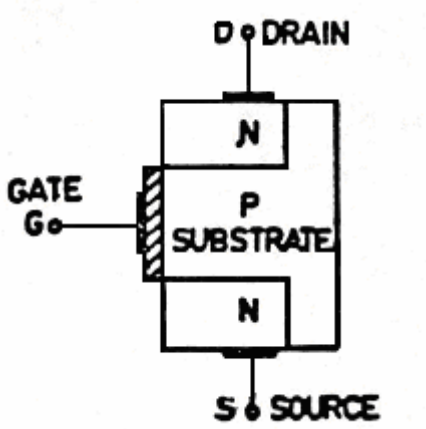
نوع التعزيز فقط Enhancement only N- channel MOSFET :

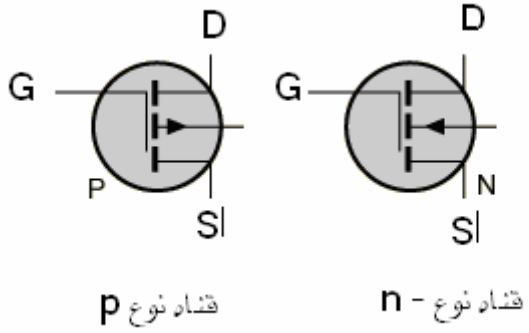
التركيب البنائي :



نفس التركيب لترانزستور DE-MOSFET إلا أن طبقة القاعدة P تمتد إلى أن تصل إلى طبقة أوكسيد السيليكون sio_2 . وبذلك لا توجد قناة بين المصرف والمنبع . وهذا النوع لا يعمل إلا إذا طبق جهد موجب كبير على البوابة G

وإذا طبق جهد سالب على البوابة لا يمكن أن يعمل وذلك لأنه بتطبيق جهد سالب على البوابة يؤدي إلى حقن شحنات موجبة في الحيز بين المصرف والمنبع وبالتالي لا يسمح بمرور الكترونات بين المنبع والمصرف ID = O

الرمز المنطقي لترانزستور نوع تعزيز فقط :



شكل (4 -11)